

2006年7月6日

半導体用CMPスラリーの生産能力を5割増強

—2010年度、売上高160億円目指す—

日立化成工業株式会社(本社：東京、執行役社長：長瀬寧次、資本金：154億円)は、半導体デバイス製造工程のCMP (Chemical Mechanical Planarization：化学的機械研磨)において使用される研磨材料で、銅配線形成時に発生した表面の凹凸を研磨、平坦化する用途で使用される銅配線用CMPスラリーの生産能力を2007年2月までに約50%増強します。

CMPとは、半導体の回路形成工程や素子分離工程で発生するウエハー上の材料(配線用金属被膜、シリコン酸化物被膜、層間絶縁材被膜等)の不用な凹凸を除去し平坦化する技術のことです。半導体デバイスの高速化、高集積化の障害となる凹凸を配線から取り除き平坦化するため、配線や素子の微細化に伴い需要が高まっています。

当社の銅配線用CMPスラリーは、世界に先駆けて提案した砥粒フリーな研磨材料で、研磨傷を大幅に低減しながら高速研磨を実現させたことが特長です。また、共に銅配線用に使用されるバリアメタル用のCMPスラリーは、微小で少量の砥粒ながらも高速研磨が可能で、銅配線のロスおよび研磨傷を低減させたものです。近年、当社はCMPスラリーのシェアを高めてきており、銅配線用CMPスラリーでは約25% (世界2位)、他用途を含むCMPスラリー全体のシェアは約17% (世界第2位)を有しています。

当社は、1998年度に酸化セリウム粒子を採用したSTI※用CMPスラリーを、2000年には銅配線用CMPスラリーを実用化し、研磨速度の速さと研磨傷の少なさを武器に拡大してきました。

今般、山崎事業所(勝田)(茨城県ひたちなか市)に生産設備を増強し、2007年2月までに生産能力を現在の約50%増に当たる年間約7,200トンに拡大します。

今後とも当社は、CMPスラリー事業をさらに強化し、2010年度には売上高を約160億円に拡大する計画です。

以上

※STI (Shallow Trench Isolation)は、シリコンウエハー上の何百万個もの半導体素子をそれぞれ電氣的に絶縁する「素子分離」の方法の一つ。形成工程上段差が生じるためCMPによる平坦化が必要とされている。

(報道関係お問い合わせ先)

日立化成工業株式会社 経営企画室(広報・IR) 野口 TEL 03-5381-2377